2SD469

NPN 三重拡散メサ形シリコントランジスタ／

NPN SILICON TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

低周波電力増幅用／Low Frequency Power Amplifier

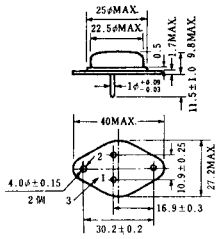
通信工業用／Industrial Use

特　徴／FEATURES

・大電流での h_{FE} を低く抑えるように設計されているため，過大電流が流れにくく，耐破壊性に優れている。
High immunity of surge current.

・計測器，端末機器等のシリーズ・レギュレータ用として最適です。
Suitable for series regulator applications.

外形図／PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)



電極接続
1. Base
2. Emitter
3. Collector

EAIJ　:TC-3, TB-3
JEDEC :TO-3
IEC　:C14A, B18

絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a=25℃)

項　目	略　号	定　格	単　位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	110	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	10	V
コレクタ電流（直流）	$I_{C(DC)}$	10	A
コレクタ電流（ピーク）	$I_{C(Peak)}$*	15	A
ベース電流（直流）	$I_{B(DC)}$	3.0	A
全損失	$P_T(T_c=25°C)$	100	W
ジャンクション温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−60～+150	℃

* PW≦10μs, duty cycle≦50%

電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a=25℃)

項　目	略　号	条　件	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}=110V, I_E=0			100	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB}=5.0V, I_C=0			100	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	V_{CE}=5.0V, I_C=1.0A*	40	80	200	
	h_{FE2}	V_{CE}=5.0V, I_C=5.0A*	20			
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=5.0V, I_B=1.0A*		0.8	2.0	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	I_C=5.0A, I_B=1.0A*		1.1	2.0	V
ターンオン時間	t_{on}	I_C=2.0A, I_{B1}=−I_{B2}=0.2A		1.0		μs
蓄積時間	t_{stg}			3.0		μs
ターンオフ時間	t_{off}			6.0		μs

* パルス測定　PW≦350μs, duty cycle≦2%／Pulsed